

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 119 031 A2**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
25.07.2001 Patentblatt 2001/30

(51) Int Cl.7: **H01L 21/306**

(21) Anmeldenummer: **01101103.8**

(22) Anmeldetag: **18.01.2001**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Benannte Erreichungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• Schwab, Günter
84547 Emmerting (DE)
• Franke, Helmut
84489 Burghausen (DE)
• Schöffberger, Manfred
84367 Reut (DE)

(30) Priorität: 20.01.2000 DE 10002354

(71) Anmelder: **Wacker Siltronic
Gesellschaft für Halbleiternaterialien
Aktiengesellschaft
84489 Burghausen (DE)**

(74) Vertreter: **Rimböck, Karl-Helz, Dr. et al
c/o Wacker-Chemie GmbH
Zentralabteilung PML
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München (DE)**

(54) **Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterschelbe**

(57) Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterschelbe durch Ätzen der Halbleiterschelbe, wobei ein Ätzmedium entlang einer Strömungsrichtung laminar zu einer Kante der Halbleiterschelbe strömt. Wesentliches Merkmal des Verfahrens ist, daß vor der Kante der Halbleiterschelbe ein Schutzschild angeordnet wird, so daß das Ätzmedium gegen das Schutzschild und nicht gegen die Kante der Halbleiterschelbe strömt. Gegenstand der Erfindung ist ferner ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet ist, daß die Halbleiterschelbe in Bezug auf die Strömungsrichtung des Ätzmediums geneigt wird, so daß zwischen der Strömungsrichtung des Ätzmediums und einer ersten Seite der Halbleiterschelbe ein Winkel von kleiner als 180° und zwischen der Strömungsrichtung des Ätzmediums und einer zweiten Seite der Halbleiterschelbe ein Winkel von größer als 180° besteht, und die zweite Seite der Halbleiterschelbe später poliert wird.

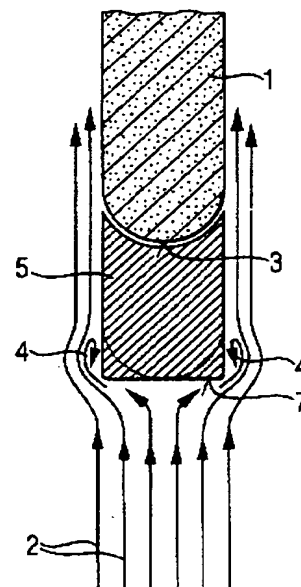


Fig. 5

EP 1 119 031 A2

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterscheibe durch Ätzen und gegebenenfalls Polieren der Halbleiterscheibe.

[0002] Verfahren zum Ätzen einer Halbleiterscheibe sind beispielsweise in der US-5,451,267, in der EP-830 640 A2 und der EP-673 545 B1 beschrieben. Dabei strömt ein Ätzmedium frontal gegen eine Kante der Halbleiterscheibe, während sich die Halbleiterscheibe gegebenenfalls dreht. Wird eine derartig behandelte Halbleiterscheibe später einseitig poliert, so ist in einem Randbereich der polierten Seite der Halbleiterscheibe eine Erhöhung feststellbar, die sich ringförmig entlang des Umfangs der Halbleiterscheibe erstreckt. Die Oberflächenstruktur einer solchen Halbleiterscheibe ist in Figur 1 dargestellt.

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterscheibe anzugeben, bei dem die Entstehung der erwähnten, im Englischen edge gutter genannten Erhöhung vermieden wird.

[0004] Gemäß einer ersten Ausgestaltung der Erfindung wird die Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterscheibe durch Ätzen der Halbleiterscheibe, wobei ein Ätzmedium entlang einer Strömungsrichtung laminar zu einer Kante der Halbleiterscheibe strömt, das dadurch gekennzeichnet ist, daß vor der Kante der Halbleiterscheibe ein Schutzschild angeordnet wird, so daß das Ätzmedium gegen das Schutzschild und nicht gegen die Kante der Halbleiterscheibe strömt.

[0005] Gemäß einer zweiten Ausgestaltung der Erfindung wird die Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterscheibe durch Ätzen und Polieren der Halbleiterscheibe, wobei beim Ätzen der Halbleiterscheibe ein Ätzmedium entlang einer Strömungsrichtung laminar zu einer Kante der Halbleiterscheibe strömt, das dadurch gekennzeichnet ist, daß die Halbleiterscheibe in Bezug auf die Strömungsrichtung des Ätzmediums geneigt wird, so daß zwischen der Strömungsrichtung des Ätzmediums und einer ersten Seite der Halbleiterscheibe ein Winkel von kleiner als 180° und zwischen der Strömungsrichtung des Ätzmediums und einer zweiten Seite der Halbleiterscheibe ein Winkel von größer als 180° besteht, und die zweite Seite der Halbleiterscheibe später poliert wird.

[0006] Die Erfindung wird nachfolgend mit Unterstützung von Figuren weiter erläutert. Figur 2 zeigt in Draufsicht eine Halbleiterscheibe und ein Schutzschild gemäß der ersten Ausgestaltung der Erfindung. Figur 3 zeigt die Anordnung einer Halbleiterscheibe relativ zur Strömungsrichtung des Ätzmediums gemäß der zweiten Ausgestaltungsform der Erfindung. In den Figuren 4 und 5 sind der Stand der Technik und die Erfindung gemäß der ersten Ausgestaltungsform einander gegenübergestellt, um die Wirkung des Schutzschields zu verdeutlichen.

[0007] Untersuchungen der Erfinder haben ergeben, daß sich das Ätzmedium hinter der Kante der Halbleiterscheibe 1 verwirbelt, wenn das Ätzmedium nach der bisher üblichen Art in einem laminaren Strom 2 frontal gegen die Kante 3 der Halbleiterscheibe strömt. Diese Situation ist in Figur 4 dargestellt. Durch die Verwirbelungen 4 entsteht ein verstärkter Ätzabtrag im Randbereich auf beiden Seiten der Halbleiterscheibe. Nach einer Politur einer Seite der Halbleiterscheibe wird daraus die erwähnte Erhöhung im Randbereich der polierten Seite der Halbleiterscheibe.

[0008] Wenn gemäß der ersten Ausgestaltung der Erfindung ein Schutzschild vor der Kante der Halbleiterscheibe angeordnet wird, dann wird eine sich ausbildende turbulente Grenzschicht des Ätzmediums von den Seiten der Halbleiterscheibe ferngehalten.

[0009] In Figur 2 ist dargestellt, wie die von einem Ätzmedium laminar angeströmte Kante der Halbleiterscheibe von einem Schutzschild abgeschirmt wird. Das Schutzschild 5 verfügt in der gezeigten Ausführungsform über Paare von Führungen 6, zwischen denen die Halbleiterscheibe 1 gehalten und gegebenenfalls gedreht wird. Die Wirkung des Schutzschields, dessen Dicke vorzugsweise der Dicke der Halbleiterscheibe entspricht, ist in Figur 5 deutlich gemacht. Eine laminare Strömung 2 des Ätzmediums trifft auf der Stirnseite 7 des Schutzschields 5 auf. Unmittelbar hinter der Stirnseite bilden sich auf beiden Seiten des Schutzschields Grenzschichten mit turbulenter Strömung 4 aus. Dies geschieht auch dann, wenn die Stirnseite wie in der Figur 5 angedeutet ist, eine abgerundete Form besitzt. Bis das Ätzmedium die Halbleiterscheibe 1 erreicht, ist die Strömung nur noch laminar, so daß ein gleichmäßiger Ätzabtrag gewährleistet ist. Dies ist nicht der Fall, wenn auf das Schutzschild verzichtet wird und das Ätzmedium frontal gegen die Kante der Halbleiterscheibe strömt.

[0010] Gemäß der zweiten Ausgestaltung der Erfindung wird auf das Schutzschild verzichtet und die Halbleiterscheibe in Bezug auf die Strömungsrichtung des zur Kante der Halbleiterscheibe strömenden Ätzmediums etwas geneigt, und die Halbleiterscheibe später poliert. Figur 3 zeigt die Situation, wenn die Halbleiterscheibe erfindungsgemäß um vorzugsweise 1 bis 10° aus der Strömungsrichtung des zur Halbleiterscheibe fließenden Ätzmediums geneigt angeordnet wird. Dann besteht zwischen der Strömungsrichtung des laminar zur Kante der Halbleiterscheibe strömenden Ätzmediums 2 und einer ersten Seite 8 der Halbleiterscheibe 1 ein Winkel von kleiner als 180° und zwischen der Strömungsrichtung des laminar zur Halbleiterscheibe strömenden Ätzmediums 2 und einer zweiten Seite 9 der Halbleiterscheibe 1 ein Winkel von größer als 180° . Beim Auftreffen des Ätzmediums auf die Kante 3 der Halbleiterscheibe verändert sich die Richtung der laminaren Strömung entsprechend der Neigung der Halbleiterscheibe. Darüber hinaus bildet sich nur hinter der Kante an der zweiten Seite 9 der Halbleiterscheibe 1

eine Grenzschicht mit turbulenter Strömung 4 aus, die in diesem Bereich der Halbleiterscheibe einen erhöhten Ätzabtrag bewirkt. Die entstehende einseitige Unebenheit der Halbleiterscheibe wird später beseitigt, indem die zweite Seite der Halbleiterscheibe poliert wird.

[0011] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, die Merkmale der beiden ersten Ausgestaltungen zu kombinieren, das heißt, ein Schutzschild vor Kante der Halbleiterscheibe anzuordnen, die Halbleiterscheibe aus der Strömungsrichtung zu neigen und später die zweite Seite der Halbleiterscheibe zu polieren.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterscheibe durch Ätzen der Halbleiterscheibe, wobei ein Ätzmedium entlang einer Strömungsrichtung laminar zu einer Kante der Halbleiterscheibe strömt, dadurch gekennzeichnet, daß vor der Kante der Halbleiterscheibe ein Schutzschild angeordnet wird, so daß das Ätzmedium gegen das Schutzschild und nicht gegen die Kante der Halbleiterscheibe strömt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Halbleiterscheibe in Bezug auf die Strömungsrichtung des Ätzmediums geneigt wird, so daß zwischen der Strömungsrichtung des Ätzmediums und einer ersten Seite der Halbleiterscheibe ein Winkel von kleiner als 180° und zwischen der Strömungsrichtung des Ätzmediums und einer zweiten Seite der Halbleiterscheibe ein Winkel von größer als 180° besteht, und die zweite Seite der Halbleiterscheibe später poliert wird.
3. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterscheibe durch Ätzen und Polieren der Halbleiterscheibe, wobei beim Ätzen der Halbleiterscheibe ein Ätzmedium entlang einer Strömungsrichtung laminar zu einer Kante der Halbleiterscheibe strömt, dadurch gekennzeichnet, daß die Halbleiterscheibe in Bezug auf die Strömungsrichtung des Ätzmediums geneigt wird, so daß zwischen der Strömungsrichtung des Ätzmediums und einer ersten Seite der Halbleiterscheibe ein Winkel von kleiner als 180° und zwischen der Strömungsrichtung des Ätzmediums und einer zweiten Seite der Halbleiterscheibe ein Winkel von größer als 180° besteht, und die zweite Seite der Halbleiterscheibe später poliert wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Halbleiterscheibe während des Ätzens gedreht wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Halbleiterscheibe um 1 bis 10° aus der Strömungsrichtung des Ätzmittels geneigt wird.

BEST AVAILABLE COPY

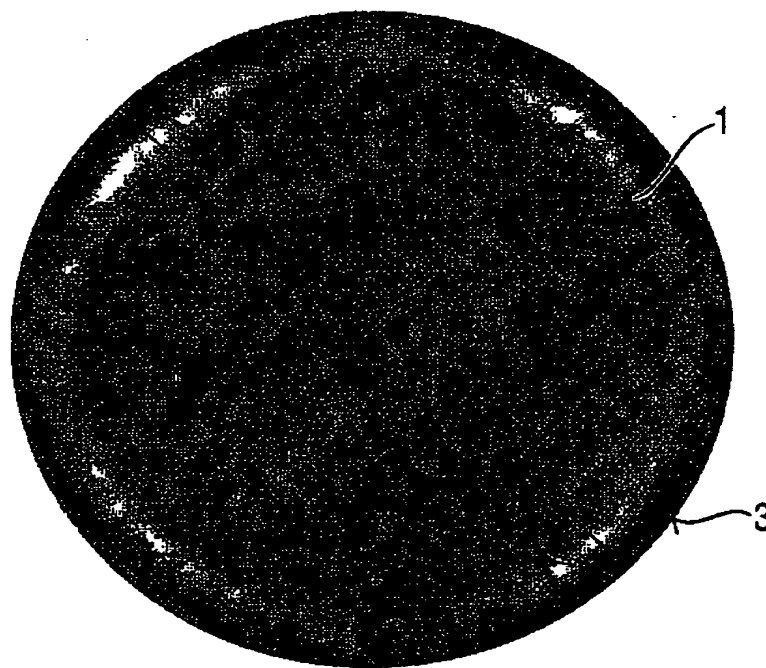
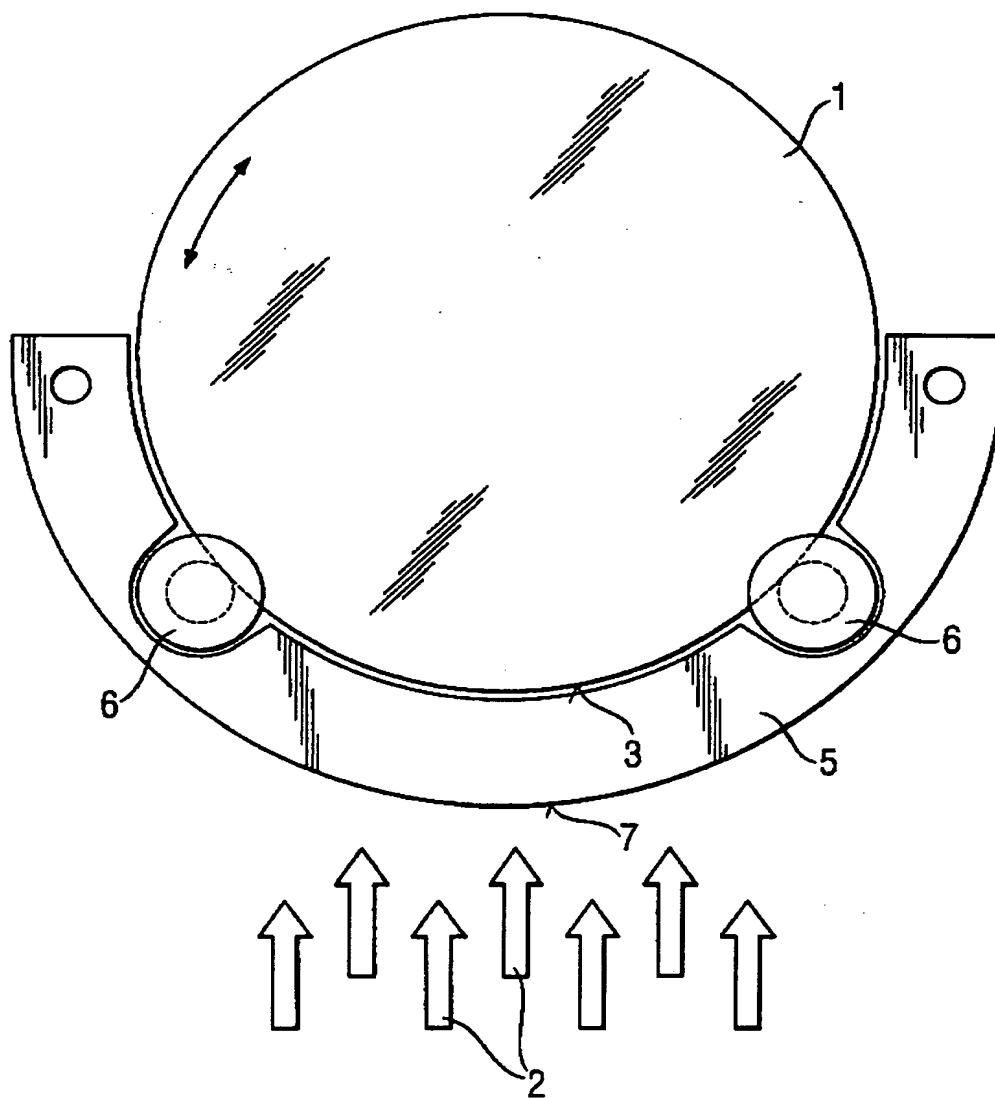


Fig. 1

Stand der Technik

Fig. 2



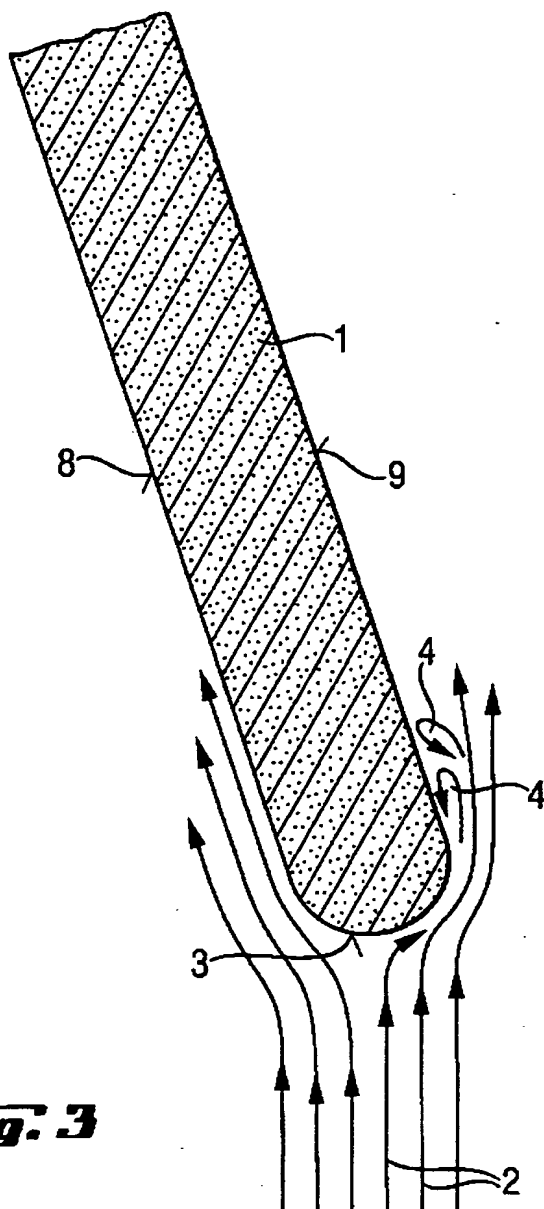


Fig. 3

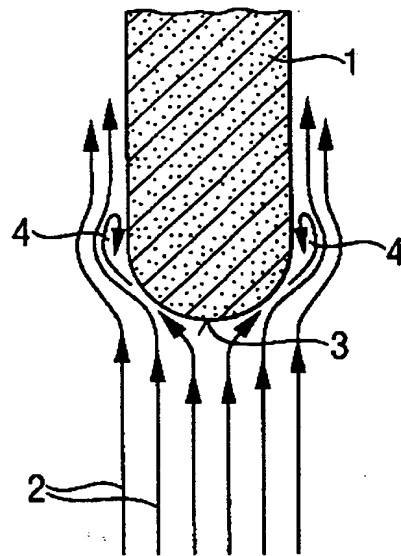


Fig. 4
Stand der Technik

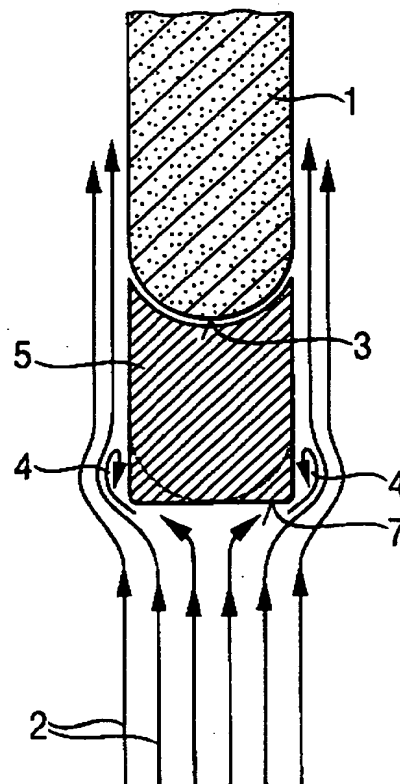


Fig. 5